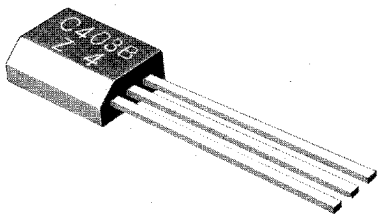
SONY®
SEMICONDUCTORS

2SC403B
2SC403C

GENERAL PURPOSE



ソニートランジスタ2SC403B, 2SC403Cは，ソニーが誇る高信頼性のエポキシモールドケース—320mW シリーズのAPM型(Advanced Passivated Mesa) シリコントランジスタで，独特の表面安定化処理により，極めて安定な高性能を有するトランジスタです。

2SC403B, 2SC403Cは，従来の2SC403Aに新たに改良を加え，高耐圧化，Pcのアップを画り，キャンケース(TO—18) と同等のPcと信頼性を持っております。また，ベース抵抗，コレクタ出力容量を吟味してありますので，直流増巾，高周波増巾，発振，周波数変換はもとより，中間周波増巾，ビデオ信号増巾にも優れた特性を発揮します。

絶対最大定格		2SC403B	2SC403C	Ta=25℃
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	50	60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	25	60	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	4		V
コレクタ電流	I_C	100		mA
コレクタ損失	P_C	320		mW
ジャンクション温度	Tj	120		℃
保存温度	Tstg	−30～+150		℃

電気的特性 Ta=25℃

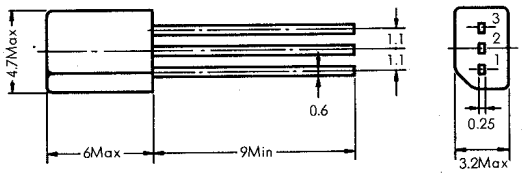
項目	記号	条件		最小値	標準値	最大値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	I_C=2mA	C403B	25			V
			C403C	60			
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	V_{CB}=25V				0.2	μA
エミッタ遮断電流	I_{EBO}	V_{EB}= 4V				0.2	μA
直流電流増巾率	h_{FE}	I_C=1mA, V_{CE}=3V		41		175	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C=50mA, I_B=10mA			0.15	0.30	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$				0.90	1.20	
小信号電流増巾率	|hfe|	I_E=−2mA, V_{CE}=6V, f=100MHz		1.0	3.0		dB
コレクタ出力容量	Cob	V_{CB}=6V, I_E=0, f=1MHz			2.0	2.7	pF
Cc・rbb′	Cc·rbb′	V_{CB}=6V, I_E=−2mA, f=1.59MHz			40	100	pS

規格細分類

品名		h_{FE}(I_C=1mA, V_{CE}=3V)
2SC403B 2SC403C	−2	41 ～ 69
	−3	51 ～ 87
	−4	65 ～ 110
	−5	82 ～ 175

外形図 Plastic Mold

Unit : mm



1. Emitter
2. Collector
3. Base